

Processos Avançados de Microeletrônica

Litografia

Aula1

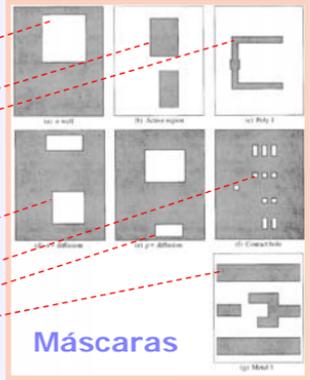
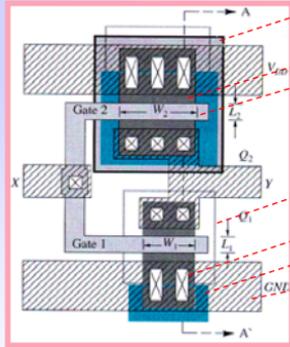
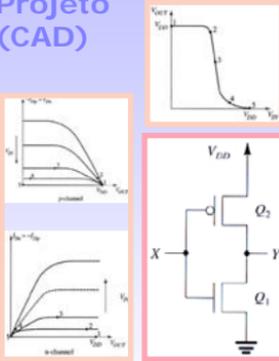
Antonio Carlos Seabra
Dep. Eng. de Sistemas Eletrônicos
Escola Politécnica da USP
acseabra@lsi.usp.br

Litografia Top-Down

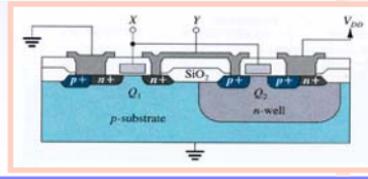
- Litografia na Indústria de CIs
 - Litografia Óptica
 - Litografia por Raios-X
 - Litografia por Feixe de Elétrons
- Litografia Top-Down para Nanotecnologia
- Aplicações

Projeto e Fabricação de CIs

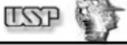
Projeto (CAD)



Máscaras

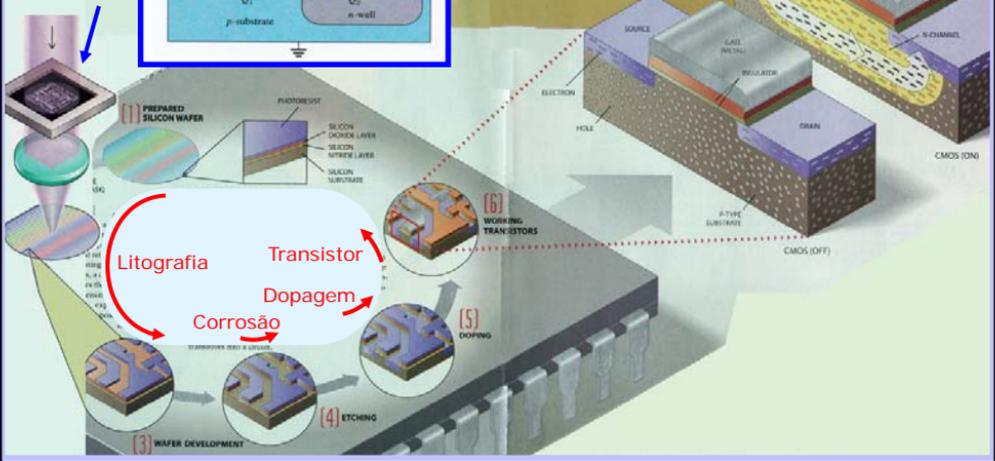
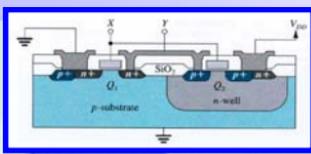


Fabricação



As Etapas de Fabricação de CIs

Máscara

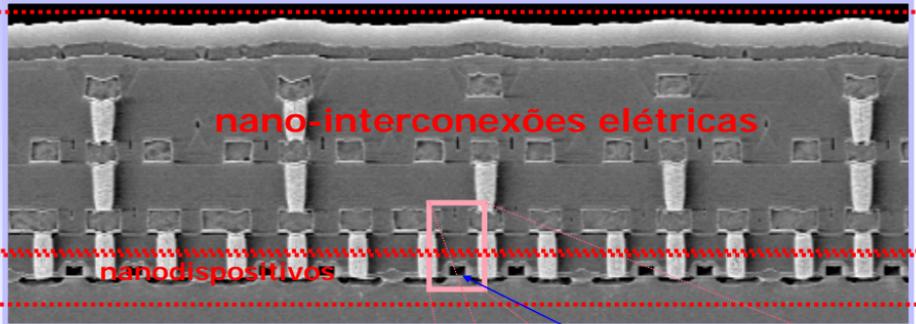


As Etapas de Fabricação de CIs

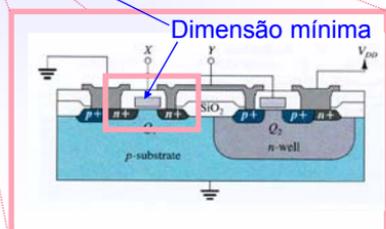
- Litografia
 - Transferência dos traçados desejados (geometrias) para uma máscara **na superfície da amostra**
- Corrosão
 - Transferência dos traçados da máscara na superfície da amostra **para as camadas de interesse, integrantes do dispositivo final**
- Portanto Litografia e Corrosão são nomes de **etapas da fabricação** e não nome dos processos de fabricação



Projeto e Fabricação de CIs



Faça certo
Faça rápido
Faça sempre



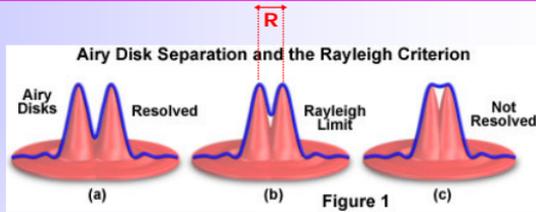
Litografia na Indústria de CIs (faça certo)

- Resolução

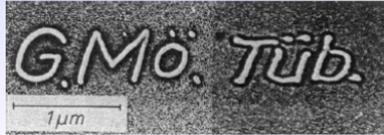
Crit. Rayleigh:

$$R = 1.22 \lambda / 2 NA$$

$$R = 0.6 \lambda / NA \text{ (obj)}$$



- Resolução e Controle da Dimensão Crítica



Mollenstaedt e Steigel, 1960

Dimensões mínimas atuais: 65nm → 45nm

Controle da dimensão crítica: 6.6nm → 4.7nm



Prof. A.C. Seabra

Processos Avançados de Microeletrônica

2015

7

Litografia na Indústria de CIs (faça certo)

- Precisão de Alinhamento (20% da menor dimensão)

25mm × 25mm



35 camadas!

$$\Delta T = 1^\circ\text{C}; \alpha \text{ do silício} = 2,33 \text{ ppm} / ^\circ\text{C} \rightarrow \Delta \ell = 60\text{nm!}$$

- Controle da dimensão crítica: 11nm → 8nm



Prof. A.C. Seabra

Processos Avançados de Microeletrônica

2015

8

Litografia na Indústria de CIs (faça certo)

Table 76a Lithography Technology Requirements—Near-term Years

Year of Production	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
DRAM 1/2 pitch (nm) (contacted)	80	70	63	57	50	45	40	36	32
DRAM and Flash									
DRAM 1/2 pitch (nm)	80	70	65	57	50	45	40	36	32
Flash 1/2 pitch (nm) (un-contacted poly)	76	64	57	51	45	40	38	32	28
Contact to resist (nm)	94	79	70	63	56	50	44	39	35
Contact after etch (nm)	85	72	64	57	51	45	40	38	32
Overlay [A] (3 sigma) (nm)	15	13	11	10	9	8	7.1	6.4	5.7
CD control (3 sigma) (nm) [B]	8.8	7.4	6.6	5.9	5.3	4.7	4.2	3.7	3.3
MPU									
MPU/ASL Metal 1 (M1) 1/2 pitch (nm)	90	78	68	59	52	45	40	38	32
MPU gate in resist (nm)	54	45	42	36	34	30	27	24	21
MPU physical gate length (nm) *	32	28	25	23	20	18	16	14	13
Contact to resist (nm)	111	97	84	73	64	56	50	44	39
Contact after etch (nm)	101	88	77	67	58	51	45	40	38
Gate CD control (3 sigma) (nm) [B] **	3.3	2.9	2.6	2.3	2.1	1.9	1.7	1.6	1.3
MPU/ASL Metal 1 (M1) 1/2 pitch (nm)	90	78	68	59	52	45	40	38	32
Chip size (mm ²)									
Maximum exposure field height (mm)	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Maximum exposure field length (mm)	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Maximum field area printed by exposure tool (mm ²)	858	858	858	858	858	858	858	858	858
Number of mask levels MPU	33	33	33	35	35	35	35	35	35
Number of mask levels DRAM	24	24	24	24	24	26	26	26	26
Wafer size (diameter, mm)	300	300	300	300	300	300	300	450	450

* MPU physical gate length numbers and colors are determined by several working groups and the ORTC.

** Noted exception for RED in next three years: Solution NOT known, but does not prevent production manufacturing.



Prof. A.C. Seabra

Processos Avançados de Microeletrônica

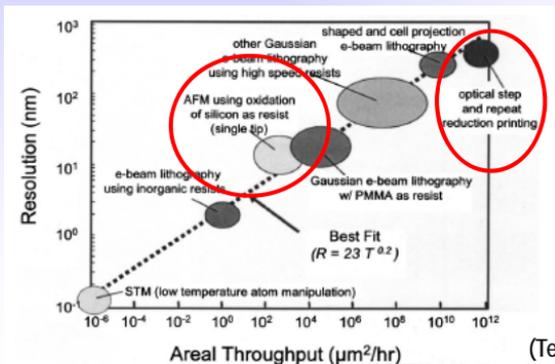
2015

9

Litografia na Indústria de CIs (faça rápido)

• Produtividade

- Lâminas de 300mm de diâmetro (+- 100 chips/lâmina – 25níveis)
- 100 lâminas (10000 exposições) por hora (lâminas/hora)
- 25 horas expõe totalmente 100 lâminas



AFM tem uma resolução 100 vezes melhor

mas é 1 bilhão de vezes mais lento

As mesmas cem lâminas levariam 30 milhões de anos...

(Tennant, Nanotechnology, 1999)



Prof. A.C. Seabra

Processos Avançados de Microeletrônica

2015

10

Litografia na Indústria de CIs (faça sempre)

- Reprodutibilidade

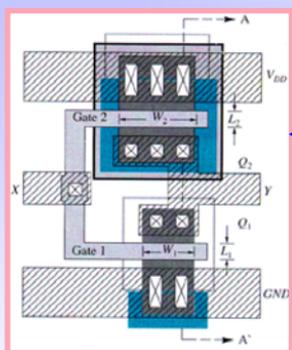
Feynman (1959): É minha intenção oferecer um prêmio de US\$ 1.000 à primeira pessoa que conseguir colocar o conteúdo escrito de uma página em uma área 25.000 vezes menor, de forma que ela possa ser lida por um microscópio eletrônico de varredura



$9 \mu\text{m} \rightarrow$ letras de $60\text{nm} \rightarrow$ o prêmio foi concedido em 1987, quase 30 anos depois!



Possibilidades Litográficas

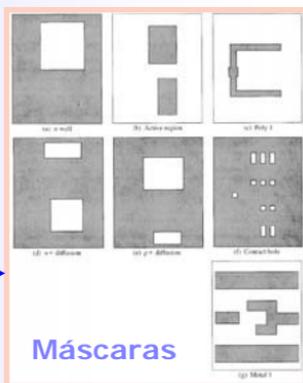


CAD

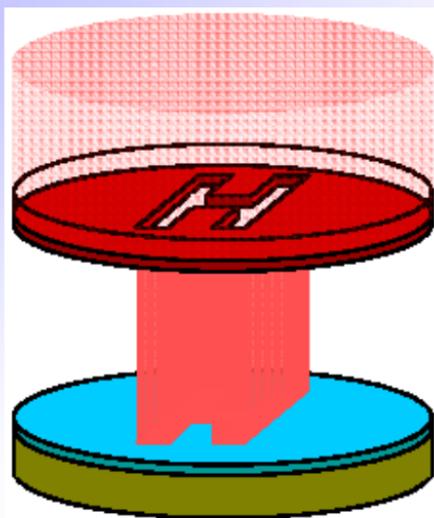
Máscara(s)

Litografia Óptica

Litografia por Raios-X



Litografia Óptica



Radiação (Exposição)

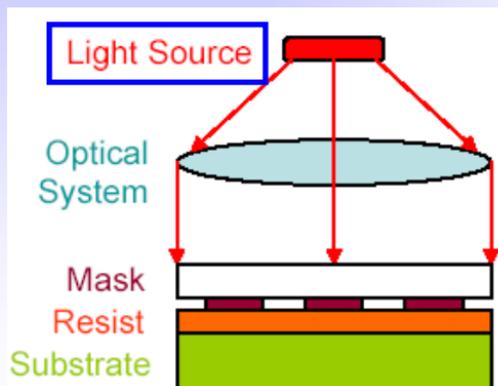
Máscara (Alinhamento)

Fotorresiste (cobertura)
Substrato



Litografia Óptica

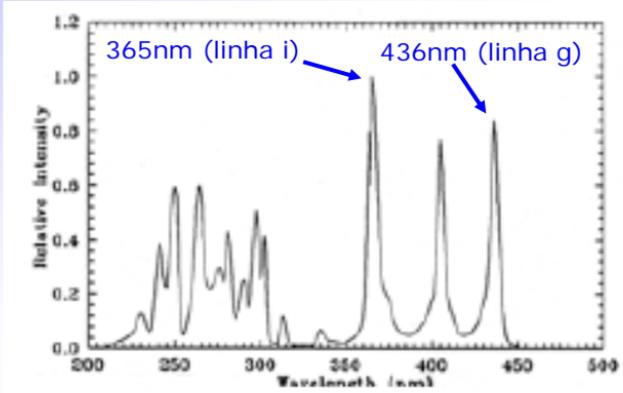
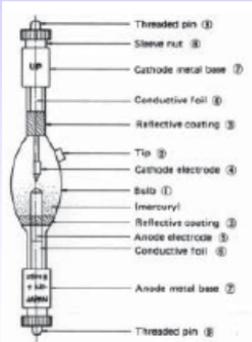
Impressão por Contato



Fonte de Luz

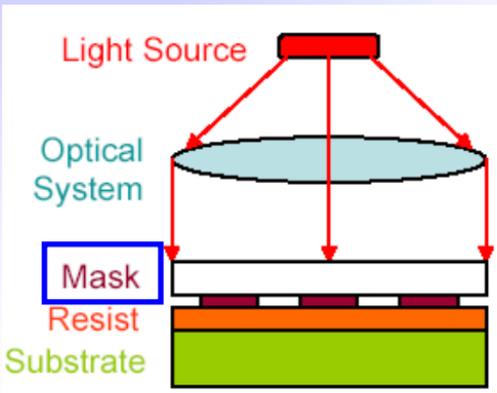
- Lâmpada de Arco - Mercúrio (fazer rápido)

USH-350DP (350W)

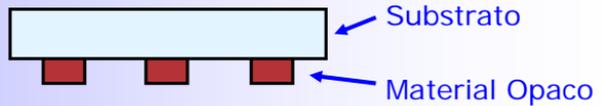


Litografia Óptica

Impressão por Contato



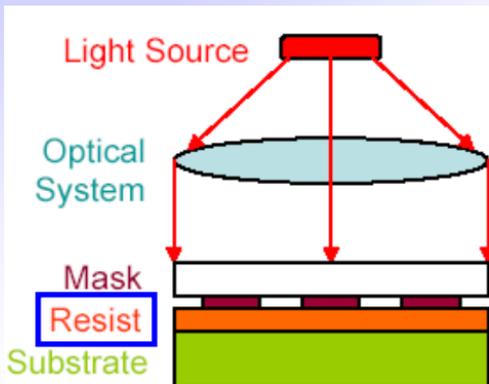
Máscara



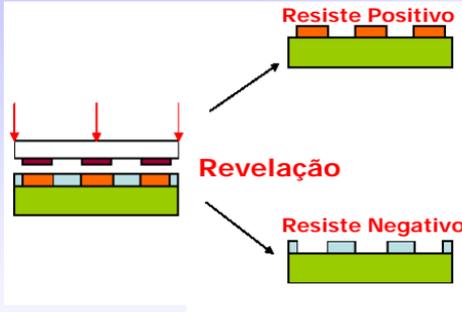
- Características do Substrato
 - Altamente transparente no comprimento de onda de interesse
 - Pequeno coeficiente de expansão térmica
 - Ópticamente plano
(Vidro de borossilicato, sílica fundida, quartzo)
- Características do Material Opaco
 - Perfeitamente opaco no comprimento de onda de interesse
 - Boa aderência ao substrato
 - Alta durabilidade
(cromo ou emulsão)

Litografia Óptica

Impressão por Contato

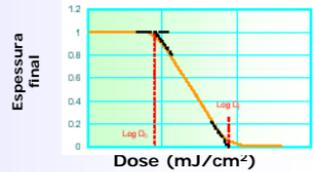


Resiste



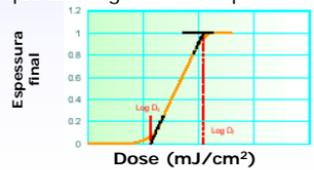
Resiste Positivo

- Solubilidade (no revelador) das regiões expostas é muito **maior** que das regiões não expostas



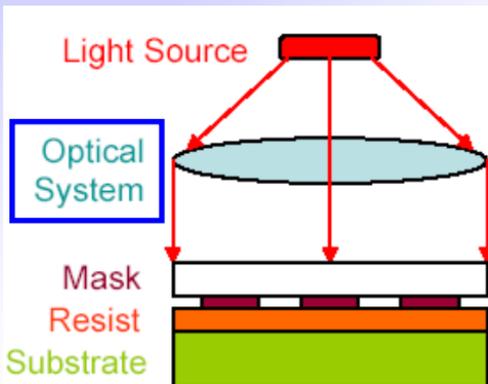
Resiste Negativo

- Solubilidade (no revelador) das regiões expostas é muito **menor** que das regiões não expostas

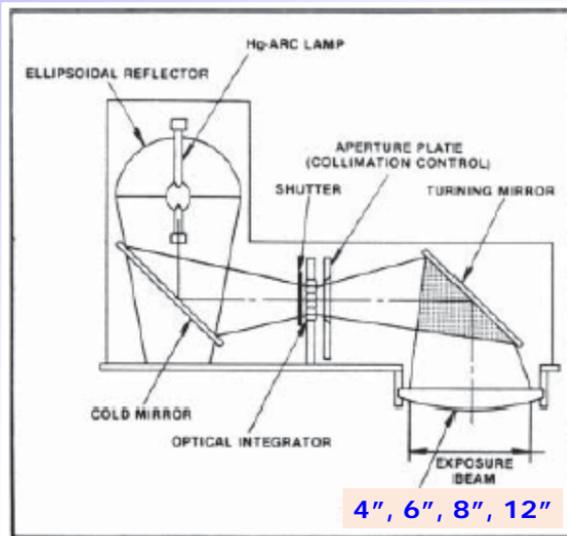


Litografia Óptica

Impressão por Contato

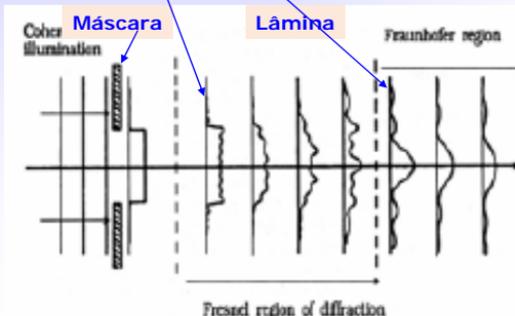


Sistema óptico: impressão por contato



Difração em Litografia por Contato

- Transfêrência par ao resiste não é perfeita devido aos fenômenos de difração óptica:
 - Difração Fraunhofer (grandes distâncias entre objeto e imagem), não é o caso
 - Difração de Fresnel (pequenas separações entre objeto e imagem)



Difração em Litografia por Contato

- Limite Teórico para linhas e espaços iguais (rede de difração)

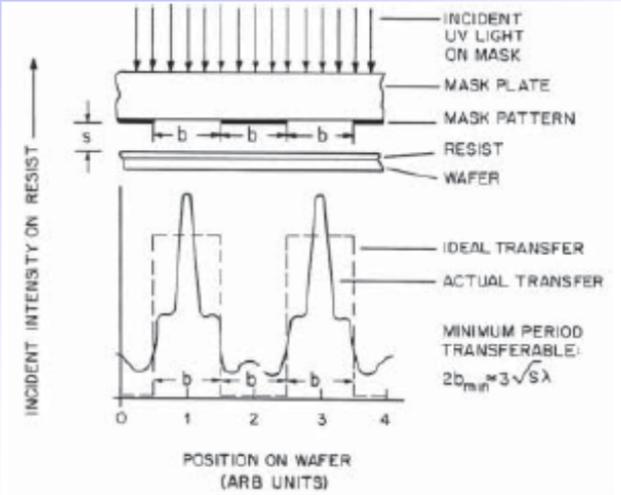
$$2b_{\min} = 3\sqrt{\lambda(s + 0,5d)}$$

$2b_{\min}$ = Período da r.d.

λ = Comprimento de onda

s = Distância másc/subst

d = Espessura do resiste



Litografia por Contato

- Para $s = 0$:

$$2b_{\min} = 3\sqrt{0,5\lambda d}$$

b_{\min}

	$\lambda = 436\text{nm}$	$\lambda = 365\text{nm}$
$d = 1\mu\text{m}$	0,70 μm	0,64 μm
$d = 0,5\mu\text{m}$	0,50 μm	0,46 μm



Problemas da Litografia por Contato

Contato!



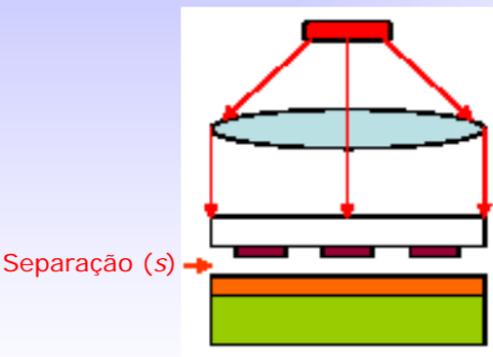
Máscara

- Substrato 3", 4", 5", 6" → Máscara 3", 4", 5", 6" (1:1)
- Dimensões mínimas na máscara = dimensões mínimas no substrato (máscara isenta de defeitos e igual aos traçados finais)



Litografia Óptica

Impressão por Proximidade



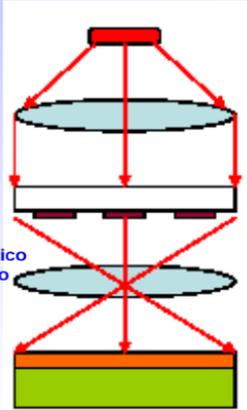
- Reduz significativamente defeitos por contato
- Degrada significativamente a resolução ($s \neq 0$):

$$2b_{\min} = 3\sqrt{\lambda(s + 0,5d)}$$

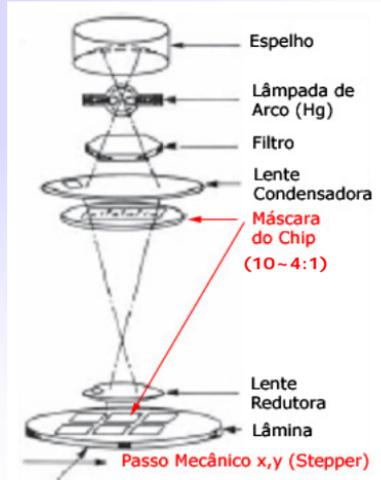
b_{\min}	$\lambda = 436\text{nm}$	$\lambda = 365\text{nm}$
$d = 0,5\mu\text{m}$ $s = 10\mu\text{m}$	6,3 μm	5,8 μm
$d = 0,5\mu\text{m}$ $s = 10\mu\text{m}$	14 μm	13 μm
	(0,50 μm)	(0,46 μm)



Possível solução: Impressão por projeção

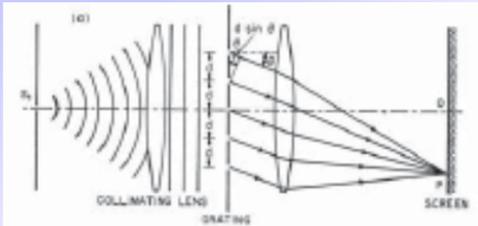


Sistema óptico de redução (10~4:1)



Impressão por Projeção

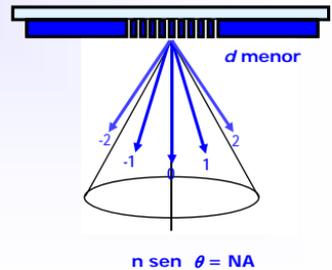
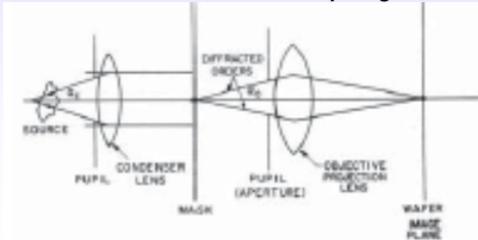
- Difração de Fraunhofer (objeto e imagem distantes)



- Ângulo onde ocorrem os máximos de intensidade quando uma onda plana incidente em uma rede de período d (no ar):

$$\text{sen } \theta = N \lambda / d \quad N = 0, 1, 2, \dots$$

- Em um sistema de projeção:



Impressão por projeção

- Estendendo o argumento para aberturas quaisquer na máscara podemos escrever:

$$d_{\min} = 2b_{\min} = R = k \lambda / NA$$

Onde k é um fator do processo litográfico (da ordem de 0,8)

- Maneiras de melhorar a resolução:
 - Diminuir λ
 - Aumentar NA
 - Melhorar o processo (reduzir k)



Impressão por projeção

- Como temos uma redução óptica, outro aspecto importante é a profundidade de foco:

$$DOF = k' \lambda / NA^2$$
 onde k' é um fator do sistema óptico

Substrato não é plano ($\sim 10\mu\text{m}$)

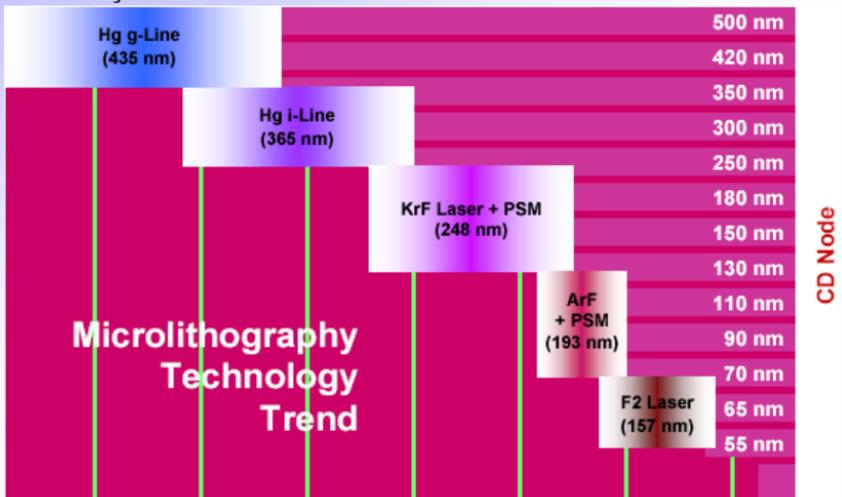
Há topografia no substrato ($\sim 1\mu\text{m}$)

- DOF reduz muito mais rápido com NA do que R melhora



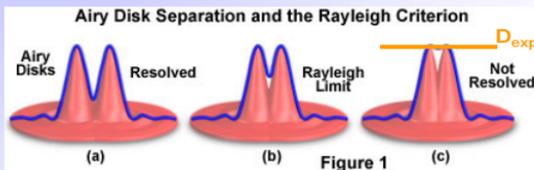
Impressão por Projeção

- A solução é reduzir λ



Impressão por Projeção

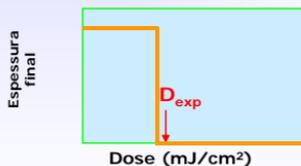
- Outra solução é reduzir k



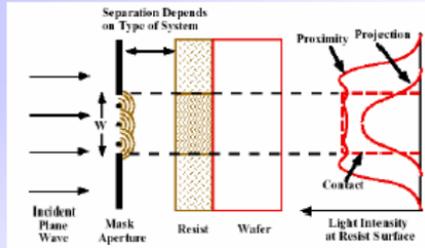
Densidade de Energia (mJ/cm²)

+

Curva de Contraste Do Resist



Comparação



Sistema	Vantagens	Desvantagens
Contato	<ul style="list-style-type: none"> Alta resolução Baixo custo Alta produtividade 	<ul style="list-style-type: none"> Contaminação da máscara Defeitos
Proximidade	<ul style="list-style-type: none"> Baixa contaminação da máscara 	<ul style="list-style-type: none"> Baixa resolução
Projeção	<ul style="list-style-type: none"> Alta resolução Baixa cont. da masc. Alta produtividade 	<ul style="list-style-type: none"> Custo



O passo natural

• Litografia por raios-X

• Benefícios

- Baixíssimos comprimentos de onda (10-0,01nm) → altíssima resolução (~20nm)
- Defeitos, particulados são transparentes aos Raios-X

• Problemas

- Fontes de luz caras (síncrotron)
- Sem óptica de redução (muito difícil, espelhos com $\lambda/20$)
- Fonte pontual erro geométrico
- Máscara de difícil fabricação (1:1), empregando materiais transparentes / opacos aos raios-X:
 - Material opaco: Metal pesado como Au
 - Material transparente: Material leve na forma de membrana (1-2 μ m de Si₃N₄)



Erro geométrico

- Erro de magnificação lateral

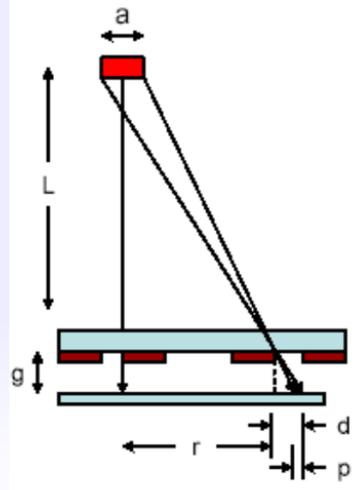
$$d = (g/L) r$$

- Zona de penumbra

$$p = (g/L) a$$

Soluções

- Pode-se corrigir a máscara para d
- Reduzir o espaçamento g (muito difícil, planicidade do substrato e da máscara)
- Aumentar L (fontes mais intensas)



Fabricação de uma máscara para Raios-X

